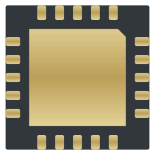
# 8000–12000 MHz GaAs 封装射频限幅器 — Pp 45 dBm; PW = 300 µs; D = 30%

LCI-LIM-8000-12000-PIP45U · 8000–12000 MHz · GaAs 封装射频限幅器.

RF 电气表参数: 插入损耗 1 dB (典型值); 限幅电平 15 dBm (典型值); 输入耐受功率 45 dBm; PW = 300 µs; D = 30%. RF 测试条件: TA = +25 °C.



QFN20 4 × 4 mm

RF输出端内置隔直电容。

T_peak ≤ 260 °C

RFin: 3

RFout: 13

GND: 2, 4, 12, 14

NC: 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20

封装外形尺寸: 4 × 4 × 0.75 mm.

## RF 特性

TA = +25 °C

| 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作频率 | f | 8000 | - | 12000 | - | MHz |
| 插入损耗 | IL | - | 1 | - | - | dB |
| 限幅电平 | PLim | - | 15 | - | - | dBm |
| 输入耐受功率 | Pp | - | - | - | 45 (PW = 300 µs; D = 30%) | dBm |

## 极限参数

极限参数，不作为正常工作设定值。

| 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最大脉冲输入功率 [1] | - | - | - | 45 | dBm |
| 储存温度 | - | -65 | - | 150 | °C |
| 工作温度 | - | -55 | - | 125 | °C |

[1] PW = 300 µs; D = 30%

## 封装外形尺寸

| 参数 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 封装外形尺寸 | 4 × 4 × 0.75 | mm |

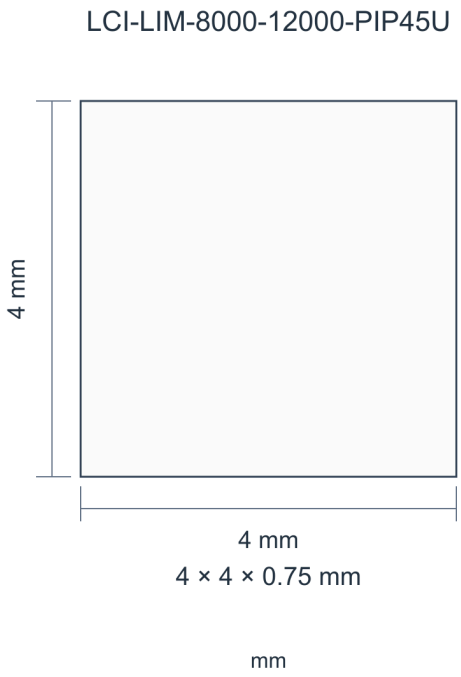
**当前出版记录** · 1.3 · 2026-11-12. 产品说明或编辑内容更新。 替代版本 1.2.

## 集成说明

QFN20 4 × 4 mm RF输出端内置隔直电容。 T_peak ≤ 260 °C RFin: 3 RFout: 13 GND: 2, 4, 12, 14 NC: 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20

## 机械外形尺寸图

安装尺寸参考图，单位为 mm。图中列出部分尺寸，安装时请参照完整安装图。




**文档说明**

规格可能随产品更新而修订。设计定版前，请向 LCRF 确认当前文档版本及具体产品要求；最终供货配置以经确认的报价和订单文件为准。